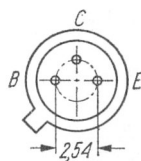
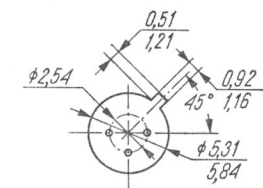


BSXP65 BSXP66 BSXP67



Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: UNITRA-CEMI

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-planarny *n-p-n* w obudowie metalowej TO-18 lub TO-46, kolektor połączony elektrycznie z obudową

Zastosowanie: układy szybkoprzełączające średniej mocy

Typy podobne: 2N2222 (Se, Ph, Tel), BFX95 (SGS)

Rys. 1-640. BSXP65, 66, 67

Wartości charakterystyczne¹⁾

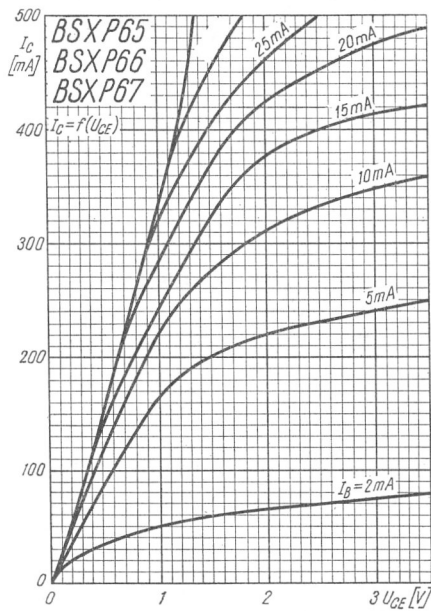
	min	typ	max		
$U_{(BR)CBO}$		60		V	przy $I_{CBO} = 10 \mu A$
$U_{(BR)CEO}$	30			V	przy $I_C = 10 mA$
$U_{(BR)EBO}$	5			V	przy $I_{EBO} = 10 \mu A$
I_{CBO}			10	nA	przy $U_{CBO} = 50 V$
I_{CBO}			3	μA	przy $U_{CBO} = 50 V, t_{amb} = 100^\circ C$
I_{EBO}			10	nA	przy $U_{EBO} = 3 V$
f_T	250			MHz	przy $I_C = 20 mA, U_{CE} = 10 V$
C_{22b}			8	pF	przy $U_{CB} = 10 V, f = 1 MHz$
C_{11b}		20		pF	przy $U_{EB} = 0,5 V, f = 1 MHz$
$r_{bb'} C_c$			300	ps	przy $I_C = 20 mA, U_{CE} = 20 V, f = 50 MHz$
t_{ON}		35		ns	
t_{OFF}		80		ns	
	BSXP 65	BSXP 66	BSXP 67		
$U_{BE sat}$	< 1,3	< 1,3	< 1,3	V	przy $I_C = 150 mA, I_B = 15 mA$
$U_{BE sat}$		< 2,6	< 2,6	V	przy $I_C = 500 mA, I_B = 50 mA$
$U_{CE sat}$	< 0,4	< 0,4	< 0,4	V	przy $I_C = 150 mA, I_B = 15 mA$
$U_{CE sat}$		< 1,6	< 1,6	V	przy $I_C = 500 mA, I_B = 50 mA$
h_{21E}		> 20	> 20		przy $I_C = 0,1 mA, U_{CE} = 10 V$
h_{21E}	> 12	> 25	> 50		przy $I_C = 1 mA, U_{CE} = 10 V$
h_{21E}	> 17	> 35	> 75		przy $I_C = 10 mA, U_{CE} = 10 V$
h_{21E}	20 ÷ 60	40 ÷ 120	100 ÷ 300		przy $I_C = 150 mA, U_{CE} = 10 V$
h_{21E}		20	30		przy $I_C = 500 mA, U_{CE} = 10 V$
h_{21E}	10	20	50		przy $I_C = 150 mA, U_{CE} = 1 V$
h_{21E}	8	16	40		przy $I_C = 150 mA, U_{CE} = 10 V, t_{amb} = -40^\circ C$

¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ C$

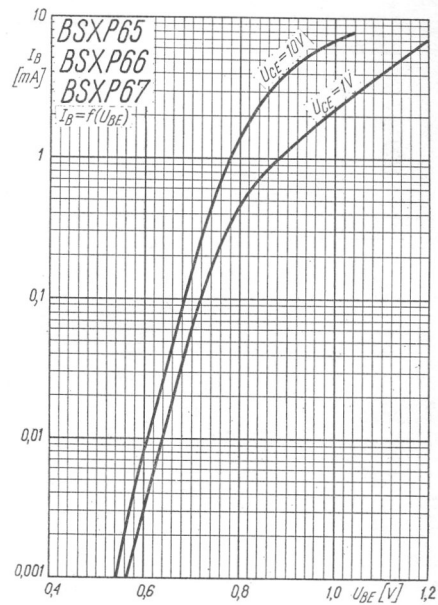
BSXP65 BSXP66 BSXP67

Wartości graniczne

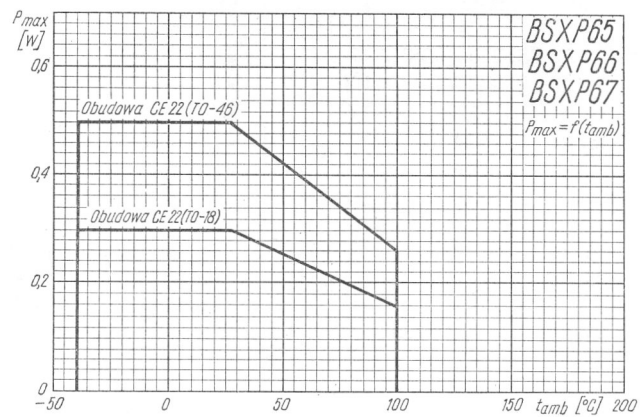
$U_{CBO\ max}$	60	V	$I_{B\ max}$	80	mA
$U_{CEO\ max}$	30	V	$t_{j\ max}$	175	°C
$U_{EB0\ max}$	5	V	$P_{tot\ max}$	wg wykresu	W
$I_{C\ max}$	0,8	mA	t_{stg}	-40 ÷ +100	°C



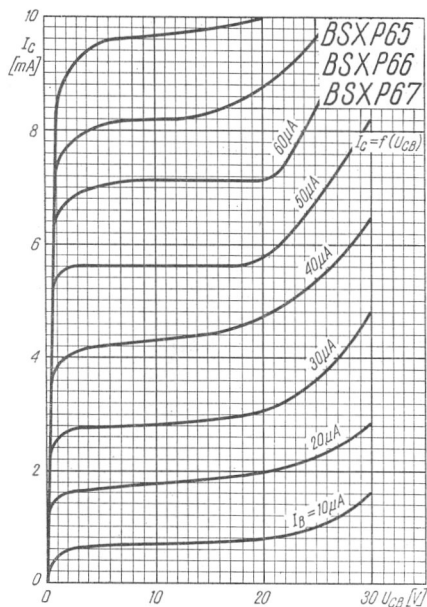
Rys. 1-641. Charakterystyki wyjściowe



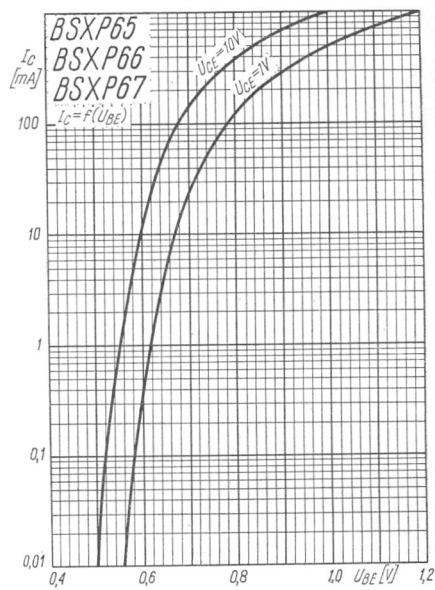
Rys. 1-642. Charakterystyki wejściowe



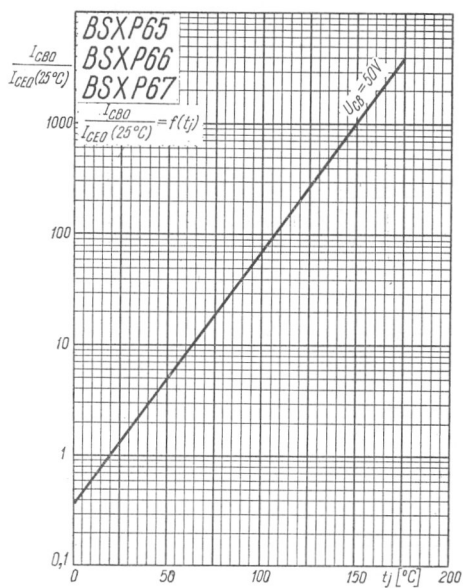
Rys. 1-643. Zależność temperaturowa mocy strat



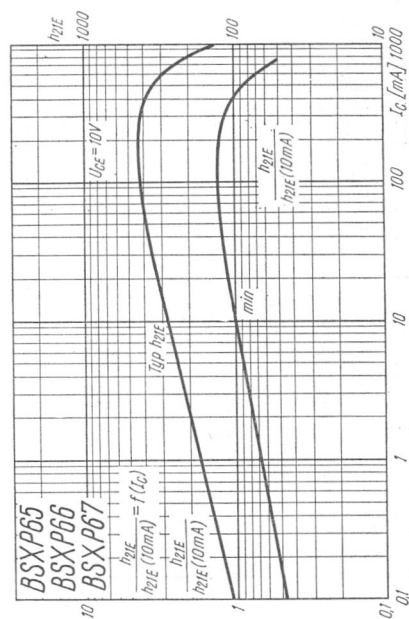
Rys. 1-644. Charakterystyki sterowania napięciowego



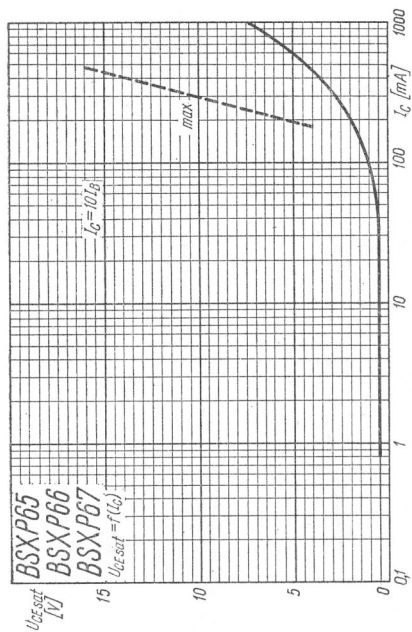
Rys. 1-645. Charakterystyki sterowania napięciowego



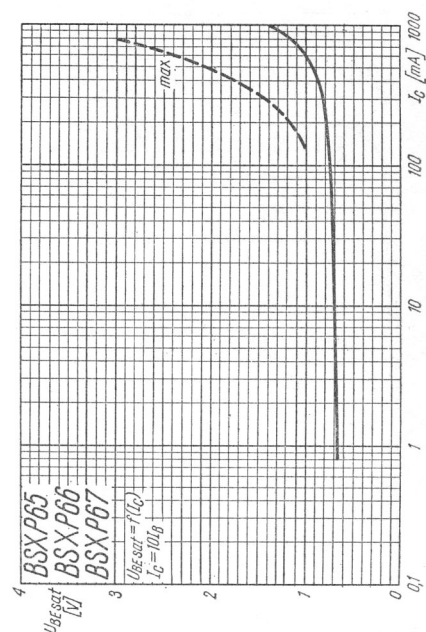
Rys. 1-646. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza



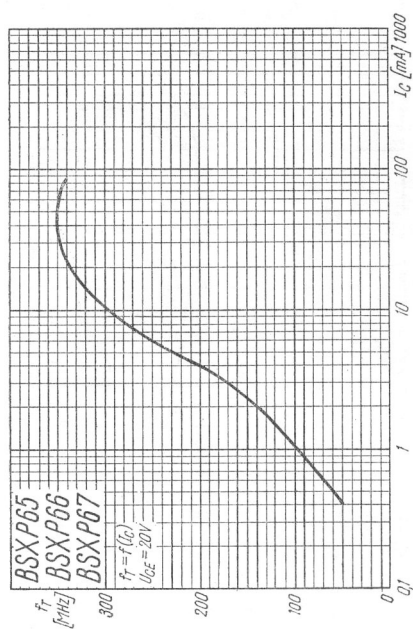
Rys. 1-647. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



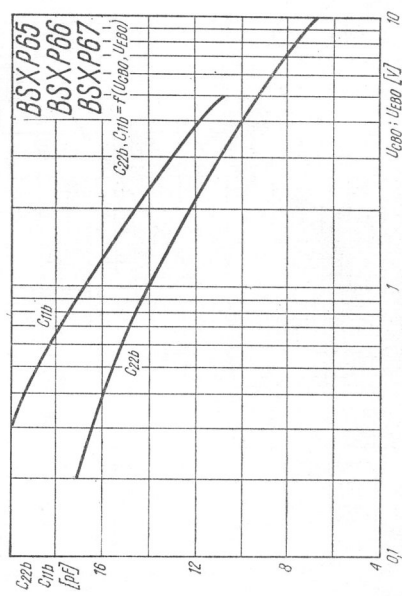
Rys. 1-648. Zależność napięcia nasycenia kolektora od prądu kolektora



Rys. 1-649. Zależność napięcia nasycenia bazy od prądu kolektora



Rys. 1-650. Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora



Rys. 1-651. Zależność napięciowa pojemności C_{22b} i C_{11b}